

삼성전자, 미국 D램라인 낸드 전환

2010년 말 8인치 100나노 공정 중단 ... 낸드 후공정 도입 수익 개선

삼성전자가 미국의 D램 생산라인을 낸드플래시 공정으로 본격 전환한다.

삼성전자는 1997년 설립한 미국 Texas 공장의 D램 라인(8인치) 가동을 2010년 말 중단하고 낸드플래시 후 공정 라인으로 전환한다고 8월16일 발표했다.

Texas 공장에서는 그동안 8인치 라인에서 100나노 공정으로 D램을 생산해왔고, 12인치 라인에서는 낸드플래시 제품을 생산했다.

삼성전자 관계자는 “그동안 수요가 있어서 100나노급 공정으로 D램을 생산해왔지만, 수익성이 떨어져 낸드플래시 후공정 라인으로 전환하기로 했다”며 “물량이 그렇게 많지는 않아 D램 시장에 영향을 미칠 정도는 아니다”고 말했다.

앞서 삼성전자는 2009년 초 8인치 D램 생산 라인(80나노급 공정)인 화성 10공장 가동을 중단한 바 있다.
<저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2009/08/17>